

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-200483
(P2009-200483A)

(43) 公開日 平成21年9月3日(2009.9.3)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
HO1L 21/316 (2006.01)	HO1L 21/316	A 4M104
HO1L 21/76 (2006.01)	HO1L 21/76	L 5FO32
HO1L 21/8234 (2006.01)	HO1L 27/08	1O2C 5FO48
HO1L 27/088 (2006.01)	HO1L 27/08	331A 5FO58
HO1L 27/08 (2006.01)	HO1L 21/283	B 5FO83

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 25 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2009-13724 (P2009-13724)	(71) 出願人	000219967 東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂五丁目3番1号
(22) 出願日	平成21年1月24日 (2009.1.24)	(74) 代理人	100115118 弁理士 渡邊 和浩
(31) 優先権主張番号	特願2008-13564 (P2008-13564)	(74) 代理人	100107559 弁理士 星宮 勝美
(32) 優先日	平成20年1月24日 (2008.1.24)	(72) 発明者	中村 秀雄 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー 東京エレクトロン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	壁 義郎 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー 東京エレクトロン株式会社内

最終頁に続く

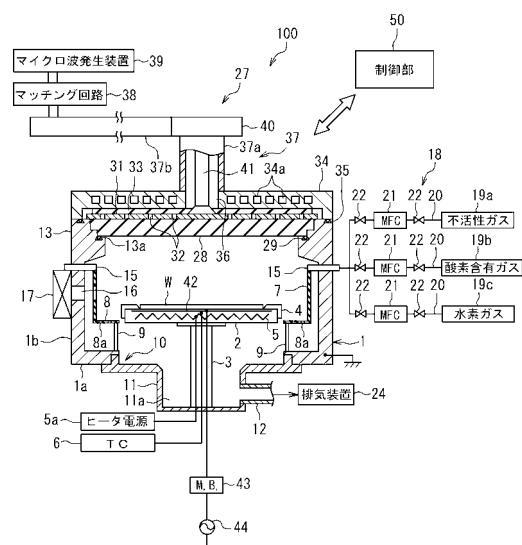
(54) 【発明の名称】シリコン酸化膜の形成方法

(57) 【要約】

【課題】 凹凸形状を有するシリコンの酸化処理において、側壁に形成されるシリコン酸化膜の膜厚を底部に比べて極力薄く形成する。

【解決手段】 複数のマイクロ波放射孔32を有する平面アンテナ板31によりチャンバー1内にマイクロ波を導入するプラズマ処理装置100を用い、載置台2に高周波電力を印加しながら、処理ガス中の酸素の割合が0.1%以上50%以下の範囲内であり、かつ処理圧力が1.3Pa異常667Pa以下の範囲内の条件でプラズマを生成させる。このプラズマにより、ウエハW上に形成された凹凸形状のシリコンの側壁面に形成されるシリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成されるシリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] が0.6以下の範囲内となるようにする。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

プラズマ処理装置の処理室内で、凹凸形状を有する被処理体の表面に露出したシリコン部分に処理ガスのプラズマを作用させて酸化処理を施し、シリコン酸化膜を形成するシリコン酸化膜の形成方法であって、

前記処理室内で被処理体を載置する載置台に被処理体の面積当り 0.2 W/cm^2 以上 2.3 W/cm^2 以下の範囲内の出力で高周波電力を印加しながら、前記処理ガス中の酸素の割合が体積比で 0.1% 以上 50% 以下の範囲内であり、処理圧力が 1.3 Pa 以上 6.7 Pa 以下の範囲内の条件で前記プラズマを生成させることにより、前記凹凸形状の側壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] を 0.6 以下とすることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。
10

【請求項 2】

請求項 1 に記載の方法において、前記処理ガス中の酸素の割合を体積比で 0.5% 以上 50% 以下とし、かつ前記処理圧力を 6.7 Pa 以上 13.3 Pa 以下とすることによって、前記凹凸形状の側壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚と、前記凹部の底壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] を 0.01 以上 0.6 以下とすることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の方法において、前記処理ガス中の酸素の割合を体積比で 0.5% 以上 25% 以下とし、かつ前記処理圧力を 20 Pa 以上 60 Pa 以下とすることによって、前記凹凸形状の側壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚と、前記凹部の底壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] を 0.01 以上 0.4 以下とすることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。
20

【請求項 4】

請求項 1 に記載の方法において、前記処理ガス中に水素を含有させることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の方法において、前記処理ガス中の水素と酸素の合計流量に対する水素流量の体積比率が 1% 以上 90% 以下の範囲内であることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。
30

【請求項 6】

請求項 1 に記載の方法において、前記高周波電力の周波数は、 100 kHz 以上 60 MHz 以下の範囲内であることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の方法において、処理温度が室温以上 600 以下の範囲内であることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項 8】

請求項 1 に記載の方法において、前記プラズマは、前記処理ガスと、複数のスロットを有する平面アンテナにより前記処理室内に導入されるマイクロ波と、によって形成されるマイクロ波励起プラズマであることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。
40

【請求項 9】

請求項 8 に記載の方法において、前記マイクロ波のパワー密度が、被処理体の面積あたり 0.255 W/cm^2 以上 2.55 W/cm^2 以下の範囲内であることを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項 10】

コンピュータ上で動作する制御プログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、

前記制御プログラムは、実行時に、プラズマ処理装置の処理室内で、凹凸形状を有する被処理体の表面に露出したシリコン部分に対し、被処理体を載置する載置台に被処理体の
50

面積当り $0.2 \text{ W} / \text{cm}^2$ 以上 $2.3 \text{ W} / \text{cm}^2$ 以下の範囲内の出力で高周波電力を印加しながら、処理ガス中の酸素の割合が体積比で 0.1% 以上 50% 以下の範囲内であり、かつ処理圧力が 1.3 Pa 以上 667 Pa 以下の範囲内である条件で生成させた処理ガスのプラズマを作用させることによって酸化処理を施し、前記凹凸形状の側壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] が 0.6 以下になるようにシリコン酸化膜を形成するシリコン酸化膜の形成方法が行われるようにコンピュータに前記プラズマ処理装置を制御せるものであることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 11】

プラズマを用いて被処理体を処理する上部が開口した処理室と、

10

前記処理室の前記開口部を塞ぐ誘電体部材と、

前記誘電体部材の外側に設けられ、前記処理室内に電磁波を導入するためのアンテナと、

前記処理室内に原料ガスを供給するガス供給機構と、

前記処理室内を減圧排気する排気機構と、

前記処理室内で被処理体を載置する載置台と、

前記載置台に接続された高周波電源と、

前記処理室内で、凹凸形状を有する被処理体表面に露出したシリコン部分に処理ガスのプラズマによる酸化処理を施してシリコン酸化膜を形成するにあたり、

20

前記載置台に被処理体の面積当り $0.2 \text{ W} / \text{cm}^2$ 以上 $2.3 \text{ W} / \text{cm}^2$ 以下の範囲内の出力で高周波電力を印加するとともに、前記ガス供給機構によって供給される前記処理ガス中の酸素の割合を体積比で 0.1% 以上 50% 以下の範囲内とし、かつ前記排気機構により処理圧力を 1.3 Pa 以上 667 Pa 以下の範囲内としながら、前記アンテナによって前記処理室内に電磁波を導入することにより前記プラズマを生成させて、前記凹凸形状の側壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] が 0.6 以下となるように制御する制御部と、

を備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【発明の詳細な説明】

30

【技術分野】

【0001】

本発明は、シリコン酸化膜の形成方法に関し、詳細には、例えば、半導体装置の製造過程でシリコンに形成されたトレンチ内を酸化したり、トランジスタのゲート電極をエッチングにより形成した後でライン & スペースの凹凸パターンに酸化処理を行ったりする場合に適用可能なシリコン酸化膜の形成方法に関する。

【背景技術】

【0002】

シリコン基板上に形成される素子を電気的に分離する技術として、シャロートレンチアイソレーション (Shallow Trench Isolation; STI) が知られている。STIでは、シリコン窒化膜などをマスクとしてシリコンをエッチングしてトレンチを形成し、その中に SiO_2 などの絶縁膜を埋め込んだ後、化学機械研磨 (CMP; Chemical Mechanical Polishing) 処理によりマスク (シリコン窒化膜) をストッパーとして平坦化する工程が実施される。STIにおいては、エッチングによって形成されたトレンチの内面を酸化処理してシリコン酸化膜を形成する工程が行われている。この酸化処理工程は、シリコン酸化膜の形成によってトレンチの形状を非鋭角的に加工することにより、リーク電流の発生などを防止することを目的としている。

【0003】

また、例えばトランジスタのゲート電極をエッチングによって形成した後に、エッチングダメージを修復する目的で、ライン & スペースの凹凸パターンに上記と同様の方法で酸

50

化処理を行うことも行われている。

【0004】

上記トレンチやライン＆スペースなどの凹凸形状を有するシリコン表面にシリコン酸化膜を形成する方法としては、酸化炉やRTP (Rapid Thermal Process) 装置を用いる熱酸化処理と、プラズマ処理装置を用いるプラズマ酸化処理に大別される。

【0005】

例えば、熱酸化処理の一つである酸化炉によるウェット酸化処理では、800超の温度にシリコン基板を加熱し、WVG (Water Vapor Generator) 装置を用いて酸化雰囲気に曝すことによりシリコン表面を酸化してシリコン酸化膜を形成する。

【0006】

熱酸化処理は、良質なシリコン酸化膜を形成できる方法であると考えられている。しかし、熱酸化処理は、800超の高温による処理が必要であることから、サーマルバジェットが増大し、熱応力によってシリコン基板に歪みなどを生じさせてしまうという問題があつた。

【0007】

一方、プラズマ酸化処理としては、アルゴンガスと酸素ガスを含み、酸素の流量比率が約1%の処理ガスを用い、133.3Paのチャンバー内圧力で形成されたマイクロ波励起プラズマをシリコン表面に作用させてプラズマ酸化処理を行なう方法が提案されている（例えば、特許文献1）。この特許文献1の方法では、処理温度が400前後と比較的低温でプラズマ酸化処理が行われるため、熱酸化処理におけるサーマルバジェットの増大や基板の歪みなどの問題を回避することができる。また、処理圧力133.3Pa程度、処理ガス中のO₂流量1%程度の条件（説明の便宜上、「低圧力、低酸素濃度条件」という）でプラズマ酸化処理を行なうことによって、高い酸化レートが得られるとともに、凹凸を有するシリコン表面を酸化した場合に、凹凸表面全体に均一な膜厚でシリコン酸化膜を形成できるとともに、凸部上端のシリコンのコーナーに丸み形状を導入し、この部位からの電界集中によるリーク電流を抑制できるという長所を有している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】WO 2004/008519号

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

近年では、半導体デバイスの微細化が益々進んでおり、パターンの寸法精度を極力高める努力が進められている。このため、STIにおけるトレンチ内面の酸化処理や、ゲートエッチング後のダメージ修復目的の酸化処理など凹凸形状を有するシリコン表面の酸化処理において、凹凸の側壁部分で横方向の酸化膜形成が進むと、デバイスを製造する領域（例えばトランジスタのゲート電極、STIにおける素子形成領域など）が酸化膜によって狭められてしまい、デバイスの微細設計が困難になる。従って、凹凸の側壁部分と底部で酸化処理の選択性を高め、側壁に形成される酸化膜を薄く形成することにより、デバイスを製造する領域の寸法精度を確保することが望まれている。

【0010】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、凹凸形状を有するシリコンの酸化処理において、側壁に形成されるシリコン酸化膜の膜厚を底部に比べて薄く形成することが可能なシリコン酸化膜の形成方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明のシリコン酸化膜の形成方法は、プラズマ処理装置の処理室内で、凹凸形状を有

10

20

30

40

50

する被処理体の表面に露出したシリコン部分に処理ガスのプラズマを作用させて酸化処理を施し、シリコン酸化膜を形成するシリコン酸化膜の形成方法であって、前記処理室内で被処理体を載置する載置台に被処理体の面積当り 0.2 W/cm^2 以上 2.3 W/cm^2 以下の範囲内の出力で高周波電力を印加しながら、前記処理ガス中の酸素の割合が 0.1% 以上 50% 以下の範囲内であり、処理圧力が 1.3 Pa 以上 667 Pa 以下の範囲内の条件で前記プラズマを生成させることにより、前記凹凸形状の側壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] を 0.6 以下とするものである。

【0012】

本発明のシリコン酸化膜の形成方法では、前記凹凸形状の側壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚と、前記凹部の底壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] が 0.01 以上 0.6 以下であり、前記処理ガス中の酸素の割合が 0.5% 以上 50% 以下の範囲内であり、かつ前記処理圧力が 6.7 Pa 以上 133 Pa 以下の範囲内である。

10

【0013】

また、本発明のシリコン酸化膜の形成方法では、前記凹凸形状の側壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚と、前記凹部の底壁面の前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] が 0.01 以上 0.4 以下であり、前記処理ガス中の酸素の割合が 0.5% 以上 25% 以下の範囲内であり、かつ前記処理圧力が 20 Pa 以上 60 Pa 以下の範囲内が好ましい。

20

【0014】

また、本発明のシリコン酸化膜の形成方法では、前記処理ガス中に水素を含有するものである。この場合、前記処理ガス中の水素と酸素の合計流量に対する水素流量の比率が 1% 以上 90% 以下の範囲内が好ましい。

【0015】

また、本発明のシリコン酸化膜の形成方法では、前記高周波電力の周波数は、 100 kHz 以上 60 MHz 以下の範囲内が好ましい。

【0016】

また、本発明のシリコン酸化膜の形成方法では、処理温度が室温以上 $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下の範囲内が好ましい。

30

【0017】

また、本発明のシリコン酸化膜の形成方法において、前記プラズマは、前記処理ガスと、複数のスロットを有する平面アンテナにより前記処理室内に導入されるマイクロ波と、によって形成されるマイクロ波励起プラズマである。この場合、前記マイクロ波のパワー密度が、被処理体の面積あたり 0.255 W/cm^2 以上 2.55 W/cm^2 以下の範囲内が好ましい。

【0018】

本発明の第2の観点のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、コンピュータ上で動作する制御プログラムが記憶されたものである。このコンピュータ読み取り可能な記憶媒体において、前記制御プログラムは、実行時に、プラズマ処理装置の処理室内で、凹凸形状を有する被処理体の表面に露出したシリコン部分に対し、被処理体を載置する載置台に被処理体の面積当り 0.2 W/cm^2 以上 2.3 W/cm^2 以下の範囲内の出力で高周波電力を印加しながら、処理ガス中の酸素の割合が 0.1% 以上 50% 以下の範囲内であり、かつ処理圧力が 1.3 Pa 以上 667 Pa 以下の範囲内である条件で生成させた処理ガスのプラズマを作用させることによって酸化処理を施し、前記凹凸形状の側壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] が 0.6 以下になるようにシリコン酸化膜を形成するシリコン酸化膜の形成方法が行われるようにコンピュータに前記プラズマ処理装置を制御せるものである。

40

【0019】

50

本発明の第3の観点のプラズマ処理装置は、プラズマを用いて被処理体を処理する上部が開口した処理室と、前記処理室の前記開口部を塞ぐ誘電体部材と、前記誘電体部材の外側に設けられ、前記処理室内に電磁波を導入するためのアンテナと、前記処理室内に原料ガスを供給するガス供給機構と、前記処理室内を減圧排気する排気機構と、前記処理室内で被処理体を載置する載置台と、前記載置台に接続された高周波電源と、前記処理室内で、凹凸形状を有する被処理体表面に露出したシリコン部分に処理ガスのプラズマによる酸化処理を施してシリコン酸化膜を形成するにあたり、前記載置台に被処理体の面積当り0.2W/cm²以上2.3W/cm²以下の範囲内の出力で高周波電力を印加するとともに、前記ガス供給機構によって供給される前記処理ガス中の酸素の割合を0.1%以上50%以下の範囲内とし、かつ前記排気機構により処理圧力を1.3Pa以上667Pa以下の範囲内としながら、前記アンテナによって前記処理室内に電磁波を導入することにより前記プラズマを生成させて、前記凹凸形状の側壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面に形成される前記シリコン酸化膜の膜厚との比[側壁面の膜厚/底壁面の膜厚]が0.6以下となるように制御する制御部と、を備えている。
10

【発明の効果】

【0020】

本発明のシリコン酸化膜の形成方法では、被処理体を載置する載置台に被処理体の面積当り0.2W/cm²以上2.3W/cm²以下の範囲内の出力で高周波電力を印加しながら、処理ガス中の酸素の割合を0.1%以上50%以下の範囲内とし、かつ処理圧力を1.3Pa以上667Pa以下の範囲内としてプラズマ酸化処理を行い、凹凸形状の側壁面と底壁面の膜厚の比[側壁面の膜厚/底壁面の膜厚]を0.6以下とする。このように極端に大きな選択比で異方性の高い酸化処理を行うことで、例えばSTIのトレンチ内のシリコン酸化膜形成やトランジスタのゲート電極エッチング後のダメージ修復のためのシリコン酸化膜形成において、凹凸形状の側壁面のシリコン酸化膜の膜厚を極力薄く形成しつつ、凹部の底壁面に十分な厚みでシリコン酸化膜を形成できる。従って、本発明のシリコン酸化膜の形成方法を各種デバイス作製過程で利用することにより、横方向の寸法ロスを極力抑え、デバイスを製造する領域の寸法精度を確保し、微細化への対応を図ることが可能になる。
20

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明のシリコン酸化膜の形成方法の実施に適したプラズマ処理装置の一例を示す概略断面図である。
30

【図2】平面アンテナの構造を示す図面である。

【図3】制御部の構成を示す説明図である。

【図4】STIにおけるトレンチ内のシリコン酸化膜形成への適用例を示す説明図である。
40

【図5】トランジスタのゲート電極エッチング後のダメージ修復目的のシリコン酸化膜形成への適用例を示す説明図である。

【図6】プラズマ処理条件と酸化処理における等方性または異方性の関係を示す説明図である。

【図7】凹凸パターンが形成されたウエハの表面付近の断面構造を示す説明図である。

【図8】実施例1～3における処理ガス中の酸素の比率と側壁/底部の膜厚比との関係を示すグラフ図面である。

【図9】実施例2～4における処理圧力と側壁/底部の膜厚比との関係を示すグラフ図面である。

【図10】実施例1～4および比較例1における処理ガス中の酸素分圧と側壁/底部膜厚比との関係を示すグラフ図面である。

【図11】実施例1におけるプラズマ酸化処理時間と、平均膜厚およびウエハ面内均一性との関係を示すグラフ図面である。

【図12】実施例2におけるプラズマ酸化処理時間と、平均膜厚およびウエハ面内均一性

10

20

30

40

50

との関係を示すグラフ図面である。

【図13】実施例5～8および比較例2、3における側壁／底部膜厚比と高周波バイアス電流の電流密度との関係を示すグラフ図面である。

【図14】実施例8におけるプラズマ酸化処理時間と、平均膜厚およびウエハ面内均一性との関係を示すグラフ図面である。

【図15】フラッシュメモリにおけるトレンチ内へのシリコン酸化膜形成への適用例を示す説明図である。

【図16】フラッシュメモリにおけるトレンチ内へのシリコン酸化膜形成への適用例を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の実施の形態にかかるシリコン酸化膜の形成方法に利用可能なプラズマ処理装置100の概略構成を模式的に示す断面図である。また、図2は、図1のプラズマ処理装置100の平面アンテナを示す平面図である。

【0023】

プラズマ処理装置100は、複数のスロット状の孔を有する平面アンテナ、特にRLSA(Radial Line Slot Antenna；ラジアルラインスロットアンテナ)にて直接処理室内にマイクロ波を導入して処理室内でプラズマを発生させることにより、高密度かつ低電子温度のマイクロ波励起プラズマを発生させ得るRLSAマイクロ波プラズマ処理装置として構成されている。プラズマ処理装置100では、 $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{12} / \text{cm}^3$ のプラズマ密度で、かつ0.7～2eVの低電子温度を有するプラズマによる処理が可能である。プラズマを生成する方式としては、誘導結合型方式(ICP, Induction Coupled Plasma)、マグネットロン方式、ECR方式(Electron cyclotron Resonance)、表面波方式で生成したプラズマも適用される。従って、プラズマ処理装置100は、各種半導体装置の製造過程において、シリコン酸化膜(例えばSiO₂膜)を形成する目的で好適に利用できる。

【0024】

プラズマ処理装置100は、主要な構成として、気密に構成されたチャンバー(処理室)1と、チャンバー1内にガスを供給するガス供給部としてのガス供給機構18と、チャンバー1内を減圧排気するための排気機構としての排気装置24と、チャンバー1の上部に設けられ、チャンバー1内にマイクロ波を導入するマイクロ波導入機構27と、これらプラズマ処理装置100の各構成部を制御する制御部50と、を備えている。

【0025】

チャンバー1は、接地された略円筒状の容器により形成されている。なお、チャンバー1は角筒形状の容器により形成してもよい。チャンバー1は、アルミニウム等の材質からなる底壁1aと側壁1bとを有している。

【0026】

チャンバー1の内部は、被処理体であるシリコン基板(ウエハW)を水平に支持するための載置台2が設けられている。載置台2は、熱伝導性の高い材質例えばAlN等のセラミックスにより構成されている。この載置台2は、排気室11の底部中央から上方に延びる円筒状の支持部材3により支持されている。支持部材3は、例えばAlN等のセラミックスにより構成されている。

【0027】

また、載置台2には、その外縁部をカバーし、ウエハWをガイドし、載置台2を覆うためのカバーリング4が設けられている。このカバーリング4は、環状に形成されていてもよく、載置台2の全面をカバーしていることが好ましい。カバーリング4によって、ウエハWへの不純物の混入防止を図ることができる。カバーリング4は、例えば石英、単結晶シリコン、ポリシリコン、アモルファスシリコン、SiN等の材質で構成され、これらの

中でも石英がもっとも好ましい。また、カバーリング4を構成する前記材質は、アルカリ金属、金属などの不純物の含有量が少ない高純度のものが好ましい。

【0028】

また、載置台2には、温度調節機構としての抵抗加熱型のヒータ5が埋め込まれている。このヒータ5は、ヒータ電源5aから給電されることにより載置台2を加熱して、その熱で被処理体であるウエハWを均一に加熱する。

【0029】

また、載置台2には、熱電対(TC)6が配備されている。この熱電対6によって温度計測を行うことにより、ウエハWの加熱温度を例えば室温から900までの範囲で制御可能となっている。

10

【0030】

また、載置台2には、ウエハWを支持して昇降させるためのウエハ支持ピン(図示せず)が設けられている。各ウエハ支持ピンは、載置台2の表面に対して突没可能に設けられている。

【0031】

チャンバー1の内周には、石英からなる円筒状のライナー7が設けられている。また、載置台2の外周側には、チャンバー1内を均一排気するため、多数の排気孔8aを有する石英製のバッフルプレート8が環状に設けられている。このバッフルプレート8は、複数の支柱9により支持されている。

20

【0032】

チャンバー1の底壁1aの略中央部には、円形の開口部10が形成されている。底壁1aにはこの開口部10と連通し、下方に向けて突出する排気室11が設けられている。この排気室11には、排気管12が接続されており、この排気管12を介して排気装置24に接続されている。

【0033】

チャンバー1の上部には、環状のアッパープレート13が接合されている。アッパープレート13の内周は、内側(チャンバー内空間)へ向けて突出し、環状の支持部13aを形成している。

【0034】

チャンバー1の側壁1bには、環状をなすガス導入部15が設けられている。このガス導入部15は、酸素含有ガスやプラズマ励起用ガスを供給するガス供給機構18に接続されている。なお、ガス導入部15はノズル状またはシャワー状に設けてもよい。

30

【0035】

また、チャンバー1の側壁1bには、プラズマ処理装置100と、これに隣接する搬送室(図示せず)との間で、ウエハWの搬入出を行うための搬入出口16と、この搬入出口16を開閉するゲートバルブ17とが設けられている。

【0036】

ガス供給機構18は、例えば不活性ガス供給源19aおよび酸素含有ガス供給源19bおよび水素ガス供給源19cを有している。なお、ガス供給機構18は、上記以外の図示しないガス供給源として、例えばチャンバー1内雰囲気を置換する際に用いるパージガス供給源、チャンバー1内をクリーニングする際に用いるクリーニングガス供給源等を有していてもよい。

40

【0037】

不活性ガスはプラズマ励起用ガスとして使われ、安定したプラズマを生成することができ、例えば希ガスなどを用いることができる。希ガスとしては、例えばArガス、Krガス、Xeガス、Heガスなどを用いることができる。これらの中でも、経済性に優れている点でArガスを用いることが特に好ましい。また、酸素含有ガスとしては、例えば酸素ガス(O₂)、水蒸気(H₂O)、一酸化窒素(NO)、一酸化二窒素(N₂O)などを用いることができる。

【0038】

50

不活性ガス、酸素含有ガスおよび水素ガスは、ガス供給機構 18 の不活性ガス供給源 19 a、酸素含有ガス供給源 19 b および水素ガス供給源から、ガスライン 20 を介してガス導入部 15 に至り、ガス導入部 15 からチャンバー 1 内に導入される。各ガス供給源に接続する各々のガスライン 20 には、マスフローコントローラ 21 およびその前後の開閉バルブ 22 が設けられている。このようなガス供給機構 18 の構成により、供給されるガスの切替えや流量等の制御が出来るようになっている。

【0039】

排気機構としての排気装置 24 は、例えばターボ分子ポンプなどの高速真空ポンプ等の真空ポンプを備えている。前記のように、真空ポンプ 24 は、排気管 12 を介してチャンバー 1 の排気室 11 に接続されている。チャンバー 1 内のガスは、排気室 11 の空間 11 a 内へ均一に流れ、さらに空間 11 a から真空ポンプ 24 を作動させることにより、排気管 12 を介して外部へ排気される。これにより、チャンバー 1 内を所定の真空度、例えば 0.133 Pa まで高速に減圧することが可能となっている。

10

【0040】

次に、マイクロ波導入機構 27 の構成について説明する。マイクロ波導入機構 27 は、主要な構成として、透過板 28、アンテナとしての平面アンテナ 31、遅波材 33、金属カバー 34、導波管 37、マッチング回路 38 およびマイクロ波発生装置 39 を備えている。

【0041】

マイクロ波を透過させる透過板 28 は、アッパープレート 13 において内周側に突出した支持部 13 a 上に配備されている。透過板 28 は、誘電体、例えば石英や Al_2O_3 、 AlN 等のセラミックス等の部材で構成されている。この透過板 28 と支持部 13 a との間は、O リング等のシール部材 29 を介して気密にシールされている。したがって、チャンバー 1 内は気密に保持される。

20

【0042】

アンテナとしての平面アンテナ 31 は、透過板 28 の上方（チャンバー 1 の外側）において、載置台 2 と対向するように設けられている。平面アンテナ 31 は、円板状をなしている。なお、平面アンテナ 31 の形状は、円板状に限らず、例えば四角板状でもよい。この平面アンテナ 31 は、アッパープレート 13 の上端に係止されている。

30

【0043】

平面アンテナ 31 は、例えば表面が金または銀メッキされた銅板、アルミニウム板、ニッケル板およびそれらの合金などの導電性部材で構成されている。平面アンテナ 31 は、マイクロ波を放射する多数のスロット状のマイクロ波放射孔 32 を有している。マイクロ波放射孔 32 は、所定のパターンで平面アンテナ 31 を貫通して形成されている。

【0044】

個々のマイクロ波放射孔 32 は、例えば図 2 に示すように、細長い長方形状（スロット状）をなしている。そして、典型的には隣接するマイクロ波放射孔 32 が「T」字状に配置されている。また、このように所定の形状（例えば T 字状）に組み合わせて配置されたマイクロ波放射孔 32 は、さらに全体として同心円状に配置されている。

40

【0045】

マイクロ波放射孔 32 の長さや配列間隔は、マイクロ波の波長（ λ ）に応じて決定される。例えば、マイクロ波放射孔 32 の間隔は、 $\lambda / 4$ 、 $\lambda / 2$ または λ となるように配置される。なお、図 2 においては、同心円状に形成された隣接するマイクロ波放射孔 32 どうしの間隔を r で示している。なお、マイクロ波放射孔 32 の形状は、円形状、円弧状等の他の形状であってもよい。さらに、マイクロ波放射孔 32 の配置形態は特に限定されず、同心円状のほか、例えば、螺旋状、放射状等に配置することもできる。

【0046】

平面アンテナ 31 の上面には、真空よりも大きい誘電率を有する遅波材 33 が設けられている。この遅波材 33 は、真空中ではマイクロ波の波長が長くなることから、マイクロ波の波長を短くしてプラズマを調整する機能を有している。遅波材の材質としては、例え

50

ば石英、ポリテトラフルオロエチレン樹脂、ポリイミド樹脂などを用いることができる。

【0047】

なお、平面アンテナ31と透過板28との間、また、遅波材33と平面アンテナ31との間は、それぞれ接触させても離間させてもよいが、接触させることが好ましい。

【0048】

チャンバー1の上部には、これら平面アンテナ31および遅波材33を覆うように、金属カバー34が設けられている。金属カバー34は、例えばアルミニウムやステンレス鋼等の金属材料によって形成されている。金属カバー34と平面アンテナ31によって、偏平導波路が形成され、マイクロ波をチャンバー1内に均一に供給できるようになっている。アッパープレート13の上端と金属カバー34とは、シール部材35によりシールされている。また、金属カバー34の内部には、冷却水流路34aが形成されている。この冷却水流路34aに冷却水を通流させることにより、金属カバー34、遅波材33、平面アンテナ31および透過板28を冷却できるようになっている。なお、金属カバー34は接地されている。

10

【0049】

金属カバー34の上壁(天井部)の中央には、開口部36が形成されており、この開口部36には導波管37が接続されている。導波管37の他端側には、マッチング回路38を介してマイクロ波を発生するマイクロ波発生装置39が接続されている。

【0050】

導波管37は、上記金属カバー34の開口部36から上方へ延出する断面円形状の同軸導波管37aと、この同軸導波管37aの上端部にモード変換器40を介して接続された水平方向に延びる矩形導波管37bとを有している。モード変換器40は、矩形導波管37b内をTEMモードで伝播するマイクロ波をTEMモードに変換する機能を有している。

20

【0051】

同軸導波管37aの中心には内導体41が延在している。この内導体41は、その下端部において平面アンテナ31の中心に接続固定されている。このような構造により、マイクロ波は、同軸導波管37aの内導体41を介して平面アンテナ31により形成される偏平導波路へ放射状に効率よく均一に伝播される。

【0052】

また、載置台2の表面側には電極42が埋設されている。この電極42にマッチングボックス(M.B.)43を介してバイアス印加用の高周波電源44が接続されており、電極42に高周波バイアス電力を供給することにより、ウエハW(被処理体)にバイアスを印加できる構成となっている。電極42の材質としては、例えばモリブデン、タンクスチンなどの導電性材料を用いることができる。電極42は、例えば網目状、格子状、渦巻き状等の形状に形成されている。

30

【0053】

以上のような構成のマイクロ波導入機構27により、マイクロ波発生装置39で発生したマイクロ波が導波管37を介して平面アンテナ31へ伝搬され、さらにマイクロ波放射孔32(スロット)から透過板28を介してチャンバー1内に導入されるようになっている。なお、マイクロ波の周波数としては、例えば2.45GHzが好ましく用いられ、他に8.35GHz、1.98GHz等を用いることもできる。

40

【0054】

プラズマ処理装置100の各構成部は、制御部50に接続されて制御される構成となっている。制御部50は、典型的にはコンピュータであり、例えば図3に示したように、CPUを備えたプロセスコントローラ51と、このプロセスコントローラ51に接続されたユーザーインターフェース52および記憶部53を備えている。プロセスコントローラ51は、プラズマ処理装置100において、例えば温度、圧力、ガス流量、マイクロ波出力、バイアス印加用の高周波出力などのプロセス条件に関係する各構成部(例えば、ヒータ電源5a、ガス供給機構18、排気装置24、マイクロ波発生装置39、高周波電源44など)を統括して制御する制御手段である。

50

【0055】

ユーザーインターフェース52は、工程管理者がプラズマ処理装置100を管理するためにコマンドの入力操作等を行うキーボードや、プラズマ処理装置100の稼働状況を可視化して表示するディスプレイ等を有している。また、記憶部53には、プラズマ処理装置100で実行される各種処理をプロセスコントローラ51の制御にて実現するための制御プログラム(ソフトウェア)や処理条件データ等が記録されたレシピなどが保存されている。

【0056】

そして、必要に応じて、ユーザーインターフェース52からの指示等にて任意のレシピを記憶部53から呼び出してプロセスコントローラ51に実行させることで、プロセスコントローラ51により制御されてプラズマ処理装置100のチャンバー1内で所望の処理が行われる。また、前記制御プログラムや処理条件データ等のレシピは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えばCD-ROM、ハードディスク、フレキシブルディスク、フラッシュメモリ、DVD、ブルーレイディスクなどに格納された状態のものを利用できる。さらに、前記レシピを他の装置から例えば専用回線を介して伝送させて利用することも可能である。

10

【0057】

このように構成されたプラズマ処理装置100では、600以下例えば室温(25程度)以上600以下の低温で、被処理体上に形成された下地膜や基板(ウエハW)等へのダメージフリーなプラズマ処理を行うことができる。また、プラズマ処理装置100は、プラズマの均一性に優れていることから、大口径のウエハW(被処理体)に対してもプロセスの均一性を実現できる。

20

【0058】

次に、RLSA方式のプラズマ処理装置100を用いたプラズマ酸化処理について説明する。まず、ゲートバルブ17を開にして搬入出口16からウエハWをチャンバー1内に搬入し、載置台2上に載置する。

20

【0059】

次に、チャンバー1内を真空ポンプにより減圧排気しながら、ガス供給機構18の不活性ガス供給源19a、酸素含有ガス供給源19bおよび水素ガス供給源19cから、不活性ガス、酸素含有ガスおよび必要に応じて水素ガスを所定の流量でそれぞれガス導入部15を介してチャンバー1内に導入する。このようにして、チャンバー1内を所定の圧力に調節する。

30

【0060】

次に、マイクロ波発生装置39で発生させた所定周波数例えば2.45GHzのマイクロ波を、マッチング回路38を介して導波管37に導く。導波管37に導かれたマイクロ波は、矩形導波管37bおよび同軸導波管37aを順次通過し、内導体41を介して平面アンテナ31に供給される。つまり、マイクロ波は、矩形導波管37b内ではTEモードで伝搬し、このTEモードのマイクロ波はモード変換器40でTEMモードに変換され、同軸導波管37a内を平面アンテナ31に向けて伝搬されていく。そして、マイクロ波は、平面アンテナ31に貫通形成されたスロット状のマイクロ波放射孔32から誘電体としての透過板28を介してチャンバー1内におけるウエハWの上方空間に放射される。この際のマイクロ波出力は、例えば200mm径以上のウエハWを処理する場合には、パワー密度として0.255~2.55W/cm²の範囲内から選択することができる。

40

【0061】

平面アンテナ31から透過板28を経てチャンバー1に放射されたマイクロ波により、チャンバー1内で電磁界が形成され、不活性ガスおよび酸素含有ガスがそれぞれプラズマ化する。このマイクロ波励起プラズマは、マイクロ波が平面アンテナ31の多数のマイクロ波放射孔32から放射されることにより、略 $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{12} / \text{cm}^3$ の高密度で、かつウエハW近傍では、略1.2eV以下の低電子温度プラズマとなる。このようにして形成されるプラズマは、基板(ウエハW)へのイオン等によるプラズマダメージが少

50

ない。その結果、プラズマ中の活性種例えばラジカルやイオンの作用によりウエハW表面に形成されたシリコン（単結晶シリコン、多結晶シリコンまたはアモルファスシリコン）に対してプラズマ酸化処理が行われ、ダメージのないシリコン酸化膜が形成される。

【0062】

また、プラズマ酸化処理を行なっている間、載置台2に高周波電源44から所定の周波数およびパワーの高周波電力を供給する。この高周波電源44から供給される高周波電力によって、基板に高周波バイアス電圧（高周波バイアス）が印加され、その結果、プラズマの低い電子温度を維持しつつ、プラズマ酸化処理の異方性が促進される。すなわち、高周波バイアスが基板に印加されることにより、基板近傍に電磁界が形成され、これがプラズマ中のイオンを基板（ウエハW）へ引き込むように作用するため、シリコンの凹部や凸部の側壁へのイオンによる酸化作用を弱め、これらの部位での酸化レートを抑制する一方で、凹部の底壁では酸化レートを増大させるように作用する。従って、シリコンの凹部や凸部の側壁では等方性の酸化が抑制されて横方向に酸化膜が形成されにくくなり、凹凸パターンの寸法精度を維持できる。それに対して、凹部の底部では、高周波バイアスによってイオンが引き込まれ、十分な膜厚でシリコン酸化膜を形成することができる。

10

【0063】

< プラズマ酸化処理条件 >

ここで、プラズマ処理装置100において行なわれるプラズマ酸化処理の好ましい条件について説明を行う。処理ガスとしては、希ガスとしてArガスを、酸素含有ガスとしてO₂ガスをそれぞれ使用することが好ましい。このとき、処理ガス中に含まれるO₂ガスの流量比率（体積比率）は、プラズマ処理の異方性を高め、凹凸の側壁の酸化を抑制しつつ、凹部の底部の酸化を促進させる観点から、0.1%以上50%以下の範囲内が好ましく、0.5%以上25%以下の範囲内がより好ましく、0.5%以上10%以下の範囲内がさらに好ましく、0.5%以上1%以下の範囲内が望ましい。つまり、チャンバー内の酸素分圧を低くしてプラズマを生成することによって、凹凸の内部はさらに酸素（イオン）分圧が低くなるので、バイアス印加により、酸素イオンが底部に引き込まれ、側壁部への酸素イオンの作用が抑制されるからである。

20

【0064】

また、本実施の形態では、処理ガス中に水素を含めることも可能である。水素を添加することにより、プラズマ中にOHラジカルが生成するため、酸化レートを増加させることができある。水素を使用する場合、高い酸化レートを得るために、処理ガス全体に対して水素と酸素の合計の流量比率（体積比率）を、0.1%以上50%以下の範囲内とすることが好ましく、0.5%以上25%以下の範囲内とすることがより好ましく、0.5%以上10%以下の範囲内とすることがさらに好ましく、0.5%以上1%以下の範囲内とすることが望ましい。この場合、水素と酸素の合計流量に対する水素流量の体積比率（[H₂流量 / (H₂ + O₂の合計流量)] × 100）を1%以上90%以下の範囲内に設定することが好ましく、凹部の底部の酸化レートを向上させる観点からは10%以上60%以下の範囲内がより好ましく、特に凹凸部の側壁に形成されるシリコン酸化膜を凹部の底部に形成されるシリコン酸化膜よりも選択的に薄く形成する観点からは1%以上50%以下の範囲内とすることが望ましい。

30

【0065】

また、処理圧力は、プラズマ酸化処理の異方性を高め、凹凸の側壁の酸化を抑制しつつ、凹部の底部の酸化を促進させる観点から、1.3Pa以上667Pa以下の範囲内に設定することが好ましく、6.7Pa以上133Pa以下の範囲内がより好ましく、20Pa以上60Pa以下の範囲内が望ましい。

40

【0066】

また、上記処理ガス中の酸素流量比率と処理圧力の好ましい組み合わせは以下のとおりである。凹凸形状の側壁面のシリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面のシリコン酸化膜の膜厚との比[側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚]を0.01以上0.6以下とする場合には、処理ガス中の酸素の割合を0.5%以上50%以下の範囲内とし、かつ処理圧力を6.7

50

Pa以上133Pa以下の範囲内とすることが好ましい。

【0067】

また、凹凸形状の側壁面のシリコン酸化膜の膜厚と、凹部の底壁面のシリコン酸化膜の膜厚との比 [側壁面の膜厚 / 底壁面の膜厚] を0.01以上0.4以下とする場合には、処理ガス中の酸素の割合を0.5%以上25%以下の範囲内とし、かつ処理圧力を20Pa以上60Pa以下の範囲内とすることが好ましい。

【0068】

本実施の形態では、プラズマ酸化処理を行なっている間、高周波電源44から所定の周波数およびパワーの高周波電力を載置台2に供給し、基板(ウエハW)に高周波バイアスを印加する。高周波電源44から供給される高周波電力の周波数は、例えば100kHz以上60MHz以下の範囲内が好ましく、400kHz以上13.5MHz以下の範囲内がより好ましい。高周波電力は、ウエハWの面積当たりのパワー密度として例えば0.2W/cm²以上2.3W/cm²以下の範囲内で印加することが好ましく、0.35W/cm²以上1.2W/cm²以下の範囲内で印加することがより好ましい。また、高周波のパワーは200W以上2000W以下の範囲内が好ましく、300W以上1200W以下の範囲内がより好ましい。載置台2に印加された高周波電力は、プラズマの低い電子温度を維持しつつ、プラズマ中のイオン種をウエハWへ引き込む作用を有している。従って、高周波電力を印加することにより、プラズマ酸化の異方性を高め、凹凸部の側壁部分に比べて底壁部分に形成されるシリコン酸化膜の膜厚を極端に大きくすることができる。また、本実施の形態では、ウエハWへ高周波バイアスを印加しても、低電子温度のプラズマであるため、シリコン酸化膜へのプラズマ中のイオン等によるダメージがなく、低温かつ短時間で良質なシリコン酸化膜を形成することが出来る。

【0069】

また、プラズマ酸化処理におけるマイクロ波のパワー密度は、ラジカル成分を減らし、異方性を向上させる観点から、0.255W/cm²以上2.55W/cm²以下の範囲内とすることが好ましい。なお、本発明においてマイクロ波のパワー密度は、ウエハWの面積1cm²あたりのマイクロ波パワーを意味する。例えば300mm径以上のウエハWを処理する場合には、マイクロ波パワーを500W以上5000W未満の範囲内とすることが好ましく、1000W以上3000W以下とすることがより好ましい。

【0070】

また、ウエハWの加熱温度は、載置台2の温度として、例えば室温(25程度)以上600以下の範囲内とすることが好ましく、200以上500以下の範囲内に設定することがより好ましく、400以上500以下の範囲内に設定することが望ましい。

【0071】

以上の条件は、制御部50の記憶部53にレシピとして保存されている。そして、プロセスコントローラ51がそのレシピを読み出してプラズマ処理装置100の各構成部例えばガス供給機構18、排気装置24、マイクロ波発生装置39、ヒータ電源5a、高周波電源44などへ制御信号を送出することにより、所望の条件でのプラズマ酸化処理が実現する。

【0072】

次に、図4(a)～図4(i)を参照しながら、本発明のシリコン酸化膜の形成方法によりSTIにおけるトレンチ内表面にシリコン酸化膜を形成する場合を例に挙げて説明する。図4(a)～図4(i)は、STIにおけるトレンチの形成とその後で行なわれる酸化膜形成までの工程を図示したものである。

【0073】

まず、図4(a)および図4(b)において、シリコン基板101に例えば熱酸化などの方法によりSiO₂などのシリコン酸化膜102を形成する。次に、図4(c)では、シリコン酸化膜102上に、例えばCVD(Chemical Vapor Deposition)によりSi₃N₄などのシリコン窒化膜103を形成する。さらに、図4(d)

10

20

30

40

50

) では、シリコン窒化膜 103 の上に、フォトレジストを塗布した後、フォトリソグラフィー技術によりパターニングしてレジスト層 104 を形成する。

【0074】

次に、レジスト層 104 をエッチングマスクとし、例えばハロゲン系のエッチングガスを用いてシリコン窒化膜 103 とシリコン酸化膜 102 を選択的にプラズマエッチングする。このようにして、レジスト層 104 のパターンに対応してシリコン基板 101 を露出させる(図 4 (e))。また、シリコン窒化膜 103 により、トレンチのためのマスクパターンが形成される。図 4 (f) は、例えば酸素などを含む処理ガスを用いた酸素含有プラズマにより、いわゆるアッシング処理を実施し、レジスト層 104 を除去した状態を示している。

10

【0075】

図 4 (g) では、シリコン窒化膜 103 およびシリコン酸化膜 102 をマスクとして、シリコン基板 101 に対し異方性プラズマエッチングを実施して、トレンチ 105 を形成する。このエッチングは、例えば Cl_2 、 HBr 、 SF_6 、 CF_4 などのハロゲンまたはハロゲン化合物や、前記ハロゲン化合物に O_2 を含むエッチングガスを使用して行なうことができる。

【0076】

図 4 (h) は、STI におけるエッチング後のウェハ W のトレンチ 105 に対し、シリコン酸化膜を形成する工程を示している。ここでは、載置台 2 の電極 42 に上記範囲の周波数およびパワー(パワー密度)で高周波電力を供給しながら、処理ガス中の酸素の割合が 0.1% 以上 5.0% 以下の範囲内で、かつ処理圧力が 1.3 Pa 以上 6.67 Pa 以下の範囲内の条件でプラズマ酸化処理を行う。このような条件でプラズマ酸化処理を行なうことにより、図 4 (i) に示したように、トレンチ 105 の内表面を酸化してシリコン酸化膜 111 を形成することができる。このように選択的な酸化処理によって形成されたシリコン酸化膜 111 は、トレンチ 105 の側壁に形成されたシリコン酸化膜 111a の膜厚と、トレンチ 105 の底部に形成されたシリコン酸化膜 111b の膜厚との比 [シリコン酸化膜 111a の膜厚 / シリコン酸化膜 111b の膜厚] が、0.6 以下(例えば 0.01 から 0.6 の範囲内(好ましくは、0.01 から 0.4 の範囲内)) であり、トレンチ 105 の側壁部分のシリコン酸化膜 111a の厚みを極端に抑えることができる。この場合、ゲート電極を形成する際にゲート長を減少させずに済み、デバイスのより微細化が実現される。

20

【0077】

STI における素子分離膜を埋めこむためのトレンチ 105 の側壁のシリコン酸化膜 111a がシリコン基板 101 内で横方向に(側壁部分を)厚膜化すると、その分デバイス形成領域(例えば、DRAM であればメモリセル形成領域)の面積が縮小させられてしまう。例えば、トレンチ 105 の側壁に形成されたシリコン酸化膜 111a の膜厚と、トレンチ 105 の底部に形成されたシリコン酸化膜 111b の膜厚との比 [シリコン酸化膜 111a の膜厚 / シリコン酸化膜 111b の膜厚] が 0.6 を超えると、寸法精度に誤差が生じて微細化への対応が困難になる。従って、デバイス形成領域の面積を十分に確保しつつ微細化を図るために、トレンチ 105 の側壁に形成されるシリコン酸化膜 111a の膜厚を選択的に極力薄くすることが必要になる。本実施の形態では、トレンチ 105 の内面の酸化処理において、底部と側壁の酸化の選択性を高くして、側壁に形成されるシリコン酸化膜 111a を底部のシリコン酸化膜 111b に比べて極端に薄く形成することにより、デバイスの微細化への対応を図ることが可能になる。

40

【0078】

なお、本実施の形態のシリコン酸化膜の形成方法によってシリコン酸化膜 111 を形成した後は、STI による素子分離領域形成の手順に従い、例えば CVD 法によりトレンチ 105 内に SiO_2 などの絶縁膜を埋込んだ後、シリコン窒化膜 103 をストッパー層として CMP (Chemical Mechanical Polishing) によって研磨を行ない平坦化する。平坦化した後は、エッチングまたは CMP によってシリコン窒

50

化膜 103 および埋込み絶縁膜の上部を除去することにより、素子分離構造が形成される。

【0079】

また、本実施の形態のシリコン酸化膜の形成方法は、トランジスタのゲートエッチング後に行われるエッチングダメージ修復のための酸化処理にも適用可能である。例えば、図 5 (a) は、トランジスタのゲート電極となるポリシリコン電極 200 に対し、プラズマ酸化処理を施している状態を示している。シリコン基板 101 上に SiO_2 等の絶縁膜 202 を介してポリシリコン層を形成し、このポリシリコン層をレジスト等のエッチングマスク 201 を利用してライン & スペースのパターン形状にプラズマエッチングすることにより、ポリシリコン電極 200 が形成される。このプラズマエッチングの際に、ポリシリコン電極 200 の側面および基板表面にプラズマダメージが入る。この例では、ポリシリコン電極 200 が形成されたシリコン基板 101 に、図 1 のプラズマ処理装置 100 を用いてプラズマ酸化処理を行うことにより、エッチングによるプラズマダメージを修復するようしている。プラズマ酸化処理は、載置台 2 に上記範囲の周波数およびパワー (パワー密度) で高周波電力を供給しながら、処理ガス中の酸素の割合が 50 % 以下例えば 0.1 % 以上 50 % 以下の範囲内で、かつ処理圧力が 667 Pa 以下例えば 1.3 Pa 以上 667 Pa 以下の範囲内の条件で行う。なお、プラズマ酸化処理により、図 5 (b) に示すように、ポリシリコン電極 200 の側面に薄いシリコン酸化膜 203 が形成される。

【0080】

トランジスタ設計上、ゲート電極となるポリシリコン電極 200 の側壁部分のシリコン酸化膜 203 が横方向 (側壁部分) に厚膜化すると、その分ポリシリコン電極 200 内でトランジスタ形成部分の面積 (チャンネル幅) が縮小してエッチングにより形成されたライン & スペースの寸法との間に誤差が生じてしまう。例えば、ポリシリコン電極 200 の側壁に形成されたシリコン酸化膜 203 の膜厚が厚くなると、上記誤差が大きくなり過ぎて、微細化への対応が困難になる。したがって、トランジスタ形成部分の面積を確保するためには、ポリシリコン電極 200 の側壁部分のシリコン酸化膜 203 の厚みを極端に薄く抑制する必要がある。本実施の形態のシリコン酸化膜の形成方法では、シリコン基板 101 とポリシリコン電極 200 の側壁との酸化処理の選択性を高め、側壁に形成されるシリコン酸化膜 203 を薄くすることにより寸法精度を維持し、微細化を図る上でもトランジスタ形成部分の面積を十分に確保することができるようになる。

【0081】

また、プラズマ処理装置 100 を用いて、凹凸形状を有するシリコン表面に対してプラズマ酸化処理を行なう場合、主として載置台 2 へ供給する高周波電力、処理圧力および処理ガス中の酸素比率を調節することにより、凹部の底部と側壁との酸化処理の選択性を制御できる。例えば、図 6 (a) に示したように、処理圧力を高くするとプラズマ中のラジカルが増加するため酸化の等方性が強くなり、逆に、処理圧力を低くするとプラズマ中のイオンが増加するため酸化の異方性が強まる。また、図 6 (b) に示したように、処理ガス中の O_2 ガスの比率を増加させるとプラズマ中のイオンが減少するために酸化の等方性が強くなり、 O_2 ガスの比率を低くするとプラズマ中のイオンが増加するために酸化の異方性が強まる。さらに、図 6 (c) に示したように、載置台 2 に供給する高周波電力が小さいと酸化の等方性が強くなり、高周波電力を大きくするに従い、プラズマ中のイオンがウエハ W へ引き込まれやすくなるために酸化の異方性が極端に強くなる。

【0082】

本実施の形態のシリコン酸化膜の形成方法では、載置台 2 に高周波電力を供給して基板 (ウエハ W) に高周波バイアスを印加し、プラズマ中のイオンを基板 (ウエハ W) に引き込むことによって酸化の異方性を極端に高めるとともに、処理圧力を 667 Pa 以下に設定し、かつ処理ガス中の O_2 比率を 50 % 以下に設定した。このような条件設定により、酸化活性種としてイオン主体の酸化を行い、凹凸形状の底部と側壁とに形成されるシリコン酸化膜の厚みを選択的に制御している。

【0083】

10

20

30

40

50

次に、本発明の効果を確認した試験結果について説明する。本実施の形態のシリコン酸化膜の形成方法を、凹凸形状（ライン＆スペース）のパターンが形成されたシリコン表面の酸化膜形成に適用した。図7は、凹凸形状のパターン120を有するシリコン基板101のシリコン表面を酸化してシリコン酸化膜121を形成した後のウエハWの表面付近の断面構造を模式的に示したものである。本試験では、図1のプラズマ処理装置100を用い、下記の条件でシリコン表面に対してプラズマ酸化処理を行ない、シリコン酸化膜121を形成した。その後、TEM写真を撮影し、その画像から、凹凸形状のパターン120における凸部のトップの膜厚a、凹部の側壁の膜厚bおよび底部の膜厚cを測定し、各部の酸化レートと側壁／底部膜厚比（b/c）を算出した。なお、パターン120における凹部の開口幅L₁は130nmであり、この開口幅L₁と凹部の深さL₂との比（アスペクト比L₂/L₁）は5であった。

10

【0084】

これらの結果を表1から表3および図8から図14に示した。側壁／底部膜厚比（b/c）は、側壁と底部との酸化の選択性の指標であり、この値が小さいほど選択性が良好である。デバイスの微細化に対応するために、側壁のシリコン酸化膜の膜厚bは極力薄く形成することが好ましいからである。側壁／底部膜厚比（b/c）は、例えば0.6以下が好ましく、0.4以下がより好ましい。

【0085】

<実施例1～4の共通条件>

高周波バイアスの周波数：13.56MHz

20

高周波バイアスのパワー：600W（パワー密度0.702W/cm²）マイクロ波パワー：1200W（パワー密度0.614W/cm²）

処理温度：465

目標膜厚：6nm（トップ膜厚aとして）

ウエハ径：300mm

<比較例1の条件>

高周波バイアスを印加しない点以外は、実施例1～4と同じである。

【0086】

【表1】

30

	実施例1 0.5%O ₂	実施例2 1%O ₂	実施例3 25%O ₂	実施例4 1%O ₂	比較例1 1%O ₂
Ar/O ₂ /H ₂ 体積比 [mL/min]	199/1/0	198/2/0	150/50/0	198/2/0	500/5/0
酸素分圧[pa]	0.2	0.4	10	1.33	1.32
処理圧力[pa]	40	40	40	133	133
処理時間[秒]	180	135	120	320	315
側壁膜厚b[nm]	2.31	2.10	2.92	3.15	5.6
底部膜厚c[nm]	9.82	7.62	7.76	8.62	4.4
側壁酸化レート[nm/min]	0.77	0.93	1.46	0.59	1.06
底部酸化レート[nm/min]	3.27	3.39	3.88	1.62	0.84
膜厚比b/c	0.235	0.276	0.376	0.365	1.272
c=6nmのときのb[nm]	1.41	1.65	2.26	2.19	—
処理時間* [秒]	110	106	93	223	429

40

※底部のシリコン酸化膜の膜厚が6nmに達するまでの処理時間

50

【0087】

表1から、プラズマ酸化処理における側壁と底部の選択性の指標である側壁／底部膜厚比 b/c に関しては、載置台2に高周波バイアスを印加せずにプラズマ酸化処理を行った比較例1では、側壁の膜厚が底部の膜厚より厚くなっている、その膜厚比 b/c は、1.272となっており、略等方的に酸化が進行したことを示している。これに対して、載置台2に高周波電力を供給しながら、40Paから133Paの範囲内の比較的低い圧力条件でプラズマ酸化処理を行った実施例1～実施例4では、側壁／底部膜厚比 b/c が0.235～0.376の範囲内であり、良好な結果を示した。これらの結果から、プラズマ酸化処理における側壁と底部の選択性を高め側壁の膜厚を薄くするには、載置台2に高周波バイアス電力を印加しながら133Pa以下例えれば6.7Pa以上133Pa以下の比較的低い圧力条件を選択することが有効であり、しかも圧力を低くするほど側壁／底部膜厚比 b/c を小さくでき側壁の膜厚を薄くできることが判明した。このことは、O₂比率が1%と同じである実施例2と実施例4における膜厚比 b/c の比較からも裏付けられた。

【0088】

また、処理圧力が同じ40Paである実施例1～実施例3の比較から、O₂比率が低いほど側壁／底部膜厚比 b/c を低く抑制できることが示された。すなわち、O₂比率が0.5%から1%の範囲内の実施例1および実施例2では、側壁／底部膜厚比 b/c が0.235～0.276の範囲内であり、O₂比率が25%の実施例3（側壁／底部膜厚比 $b/c = 0.376$ ）に比べて側壁の膜厚を薄くできるという優れた結果を示した。これは、溝内の酸素イオン、ラジカルの分圧が低くなることで、側壁への酸化作用が抑制されることによるものである。

【0089】

図8は、実施例1から実施例3におけるプラズマ酸化処理での側壁と底部の膜厚比 b/c と処理ガス中の酸素ガスの割合との関係をグラフ化したものである。この図8から、処理圧力が40Paの条件で、処理ガス中の酸素ガスの体積比率を50%以下にすれば、側壁／底部膜厚比 b/c を0.6以下にすることが可能であり、同体積比率を25%以下にすれば側壁／底部膜厚比 b/c を0.4以下にできることが判明した。

【0090】

図9は、実施例2～4におけるプラズマ酸化処理での側壁と底部の膜厚比 b/c と処理圧力との関係をグラフ化したものである。この図9から、1%O₂の条件で、処理圧力267Pa以下にすれば、側壁／底部膜厚比 b/c を0.6以下にすることが可能であり、処理圧力を133Pa以下にすれば、側壁／底部膜厚比 b/c を0.4以下にでき側壁の膜厚を薄くできることが判明した。

【0091】

図10のグラフは、実施例1～4および比較例1におけるシリコン酸化膜の側壁／底部膜厚比 b/c と処理ガス中の酸素分圧との関係をプロットしたものである。この図10より、側壁／底部膜厚比 b/c が0.4以下の、薄い膜厚の側壁にするためには処理ガス中の酸素分圧を10以下とすることが好ましく、2以下とすることがより好ましいことがわかる。

【0092】

図11は、実施例1におけるプラズマ酸化処理時間と、トップ膜厚 a の平均膜厚および該平均膜厚のウエハ面内均一性との関係を示している。この図11に示されるように、実施例1の条件でプラズマ酸化処理を行った場合には、約180秒で目標膜厚（トップ膜厚 $a = 6\text{ nm}$ ）に達しており、十分な酸化レートが得られている。また、プラズマ酸化処理におけるウエハ面内均一性は、4%以下で推移しており良好な結果であった。なお、図11におけるウエハ面内均一性は、（ウエハ面内の最大膜厚 - 同最小膜厚）/（ウエハ面内の平均膜厚 × 2）の百分率（×100%）により算出した（図12、図14も同様である）。

【0093】

10

20

30

40

50

図12は、実施例2におけるプラズマ酸化処理時間と、トップ膜厚aの平均膜厚および該平均膜厚のウエハ面内均一性との関係を示している。この図12に示されるように、実施例1の条件でプラズマ酸化処理を行った場合には、約135秒で目標膜厚(トップ膜厚a=6nm)に達しており、十分な酸化レートが得られている。また、プラズマ酸化処理におけるウエハ面内均一性は、ほぼ2%以下で推移しており極めて良好な結果であった。

【0094】

図11および図12から、側壁/底部膜厚比b/cが0.4以下であった実施例1および実施例2のプラズマ酸化処理条件においても、実用上十分な酸化レートとウエハ面内均一性が得られることが確認された。

【0095】

次に、処理ガス中に水素を添加した実施例5~8および比較例2、3の試験結果について、表2、表3、図13および図14を参照しながら説明する。

【0096】

<実施例5~8、比較例3の共通条件>

高周波バイアスの周波数: 13.56MHz

マイクロ波パワー: 1200W (パワー密度0.614W/cm²)

処理温度: 465

目標膜厚: 6nm (トップ膜厚aとして)

ウエハ径: 300mm

<比較例2の条件>

高周波バイアスを印加しない点以外は、実施例5~8、比較例3と同じである。

【0097】

【表2】

	実施例5 (23%O ₂ /2%H ₂)	実施例6 (0.5%O ₂ /0.5%H ₂)	実施例7 (0.5%O ₂ /0.5%H ₂)	実施例8 (0.5%O ₂ /0.5%H ₂)
Ar/O ₂ /H ₂ 体積比[mL/min]	1200/370/32	198/1/1	198/1/1	198/1/1
酸素分圧[Pa]	154	0.2	0.2	0.2
水素分圧[Pa]	12.5	0.2	0.2	0.2
バイアス電力密度[W/cm ²]	0.67	0.2	0.35	0.7
処理圧力[Pa]	667	40	40	40
処理時間[秒]	45	55	80	90
側壁膜厚b[nm]	4.1	4.7	4.2	3.56
底部膜厚c[nm]	6.7	7.6	10.5	10.65
側壁酸化レート[nm/min]	2.05	5.12	3.15	2.37
底部酸化レート[nm/min]	8.93	8.5	7.9	7.10
膜厚比b/c	0.6	0.6	0.4	0.3
H ₂ /(H ₂ +O ₂) 流量比率[%]	7.5	50	50	50
処理時間* [秒]	40	42	46	51

*底部のシリコン酸化膜の膜厚が6nmに達するまでの処理時間

【0098】

【表3】

	比較例2 (23%O ₂ /2%H ₂)	比較例3 (23%O ₂ /2%H ₂)
Ar/O ₂ /H ₂ 体積比 [mL/min]	1200/370/30	1200/370/31
酸素分圧 [Pa]	154	154
水素分圧 [Pa]	12.5	12.5
バイアス電力密度 [W/cm ²]	0	0.16
処理圧力 [Pa]	667	667
処理時間 [秒]	710	105
側壁膜厚b [nm]	7.2	4.7
底部膜厚c [nm]	6.5	6.1
側壁酸化レート [nm/min]	0.61	2.68
底部酸化レート [nm/min]	0.55	3.48
膜厚比 b / c	1.2	0.8
H ₂ /(H ₂ +O ₂) 流量比率 [%]	7.5	7.5
処理時間* [秒]	652	103

※底部のシリコン酸化膜の膜厚が 6 nm に達するまでの処理時間

10

20

30

40

50

【0099】

表2および表3から、処理ガス中にH₂を添加し、かつ載置台2に高周波バイアス電力を印加しながらプラズマ酸化処理を行うことによって、酸化レートを大幅に向上させ得ることが示された。水素の割合は0.1%以上2%未満が好ましく、0.1%~1%がより好ましい。また、H₂を添加しても、実施例5から8のように、載置台2に高周波バイアス電力を0.2 [W/cm²]以上の電力密度で印加しながらプラズマ酸化処理を行うことによって、側壁と底部の選択性(つまり、側壁/底部膜厚比b/c)が実用上十分な値(側壁/底部膜厚比b/c=0.3~0.6)であった。特に、40Paの処理圧力でプラズマ酸化処理を行った実施例8は、膜厚比b/c=0.3であり、高い酸化レートと側壁と底部の高い選択性とを両立でき、側壁の膜厚を薄くすることが出来た。このように、処理ガス中にH₂を添加することにより、酸化レートを高め、スループットを向上させ得ることが判明した。

【0100】

また、実施例5から実施例8および比較例2、3におけるシリコン酸化膜の側壁/底部膜厚比b/cと高周波バイアスの電力密度(バイアスパワー)との関係を図13に示した。表2および図13より、処理圧力が667Paのときは、被処理体に印加する高周波バイアスの電力密度を0.2 [W/cm²]以上とすることによって、側壁/底部膜厚比b/cを0.6以下にでき、側壁の膜厚を薄くできることが判明した。また、処理圧力が40Paのときは、被処理体に印加する高周波バイアスの電力密度を0.2 [W/cm²]以上とすることによって側壁/底部膜厚比b/cを0.6以下にすることが可能であり、さらに高周波バイアスの電力密度を0.35 [W/cm²]以上とすることによって、側壁/底部膜厚比b/cを0.4以下にでき、側壁の膜厚を薄く出来ることが判明した。

【0101】

一方、処理ガス中に水素を添加した場合でも、被処理体(ウエハW)に高周波バイアスを印加しなかった比較例2や、高周波バイアスの電力密度が0.16 [W/cm²]と小さかった比較例3では、十分な酸化レートが得られず、しかも膜厚比b/cが0.8~1.2と選択性が低い結果となった。従って、プラズマ酸化処理における側壁と底部の高い選択性を得ながら、側壁の膜厚を薄くし、酸化レートを大きくしたい場合には、載置台2に

高周波バイアス電力を供給しながら、処理ガス中にH₂を添加することが好ましいことが判明した。

【0102】

図14は、実施例8におけるプラズマ酸化処理時間と、トップ膜厚aの平均膜厚および該平均膜厚のウエハ面内均一性との関係を示している。この図14に示されるように、実施例8の条件でプラズマ酸化処理を行った場合には、約90秒で目標膜厚(トップ膜厚a=6nm)に達しており、非常に大きな酸化レートが得られている。このように、処理ガス中にH₂を添加することにより、7.1nm/minという大きな酸化レートを実現することができ、側壁の膜厚を薄く維持しつつスループットを向上させ得ることが確認できた。

10

【0103】

以上詳述したように、プラズマ処理装置100を使用し、凹凸パターンを有するウエハWの表面に露出したシリコン部分に処理ガスのプラズマによる酸化処理を施してシリコン酸化膜を形成する場合に、処理ガス中の酸素の割合を0.1%以上50%以下の範囲内とし、かつ処理圧力を1.3Pa以上667Pa以下の範囲内とすることにより、側壁/底部膜厚比b/cを0.6以下例えば0.01以上0.6以下の範囲内にすることができる。従って、例えばSTIにおけるトレンチ内の酸化処理や、トランジスタのゲートエッチング後のエッチングダメージ修復のための酸化などにおいて、側壁部分の酸化膜厚を極力薄くしながら、底部に必要な膜厚でシリコン酸化膜を選択的に形成することができる。その結果、凹凸パターンの横方向の寸法精度が確保され、デバイスの微細設計への対応が可能になる。

20

【0104】

また、処理ガス中にH₂を添加することにより、酸化レートを高くして短時間に凹凸形状の凹部の底壁面に20nm以下例えば6nm以上20nm以下の範囲内の膜厚でかつ、側壁には0.6nm以上12nm以下の膜厚でシリコン酸化膜を薄く形成することができる。

20

【0105】

以上、本発明の実施の形態を挙げて説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されることなく、種々の変形が可能である。例えば上記実施の形態では、本発明のシリコン酸化膜の形成方法を行う装置として最適なRLSA方式のプラズマ処理装置を例に挙げて説明した。しかし、例えばICPプラズマ方式、ECRプラズマ方式、表面反射波プラズマ方式、マグネットロンプラズマ方式等の他のプラズマ処理装置を使用することも可能である。

30

【0106】

また、上記実施の形態では、凹凸パターンに対するシリコン酸化膜形成の例として、STIにおける単結晶のシリコン基板101のトレンチ105内部の酸化処理、およびエッチングによってトランジスタのポリシリコンゲート電極を形成した後のエッチングダメージ修復のための酸化処理について説明した。しかし、本発明のシリコン酸化膜の形成方法は、凹凸パターンの表面にシリコン酸化膜を形成する必要性の高い他の種々のアプリケーションにも適用できる。さらに、凹凸によって部位により面方位が相違するシリコン表面例えばフィン構造や溝ゲート構造などの3次元トランジスタの製造過程で、ゲート絶縁膜等としてのシリコン酸化膜を選択的に側壁に薄く形成する場合にも適用可能である。また、逆に凹凸シリコンの底部に選択的に厚くシリコン酸化膜を形成したい場合にも適用できる。

40

【0107】

図15および図16に、本発明に係るシリコン酸化膜の形成方法を、フラッシュメモリを製造する工程に適用した事例を示す。図15(a)に示すように、まず、シリコン基板301上に、基板を熱酸化処理してSiO₂の第1の絶縁膜層302を形成し、その上にCVDにより第1のポリシリコン層303、Si₃N₄層およびSiO₂層で構成される第2の絶縁膜層304を積層形成し、さらにその上に第2のポリシリコン層305を形成する。周知のように、フラッシュメモリデバイスでは、第1の絶縁層302はトンネル酸化

50

膜として作動し、第1のポリシリコン層303はフローティングゲートとして作動し、第2のポリシリコン層305はコントロールゲートとして作動する。これらの層をシリコン基板301上に形成する方法についても、周知である。

【0108】

図15(a)には示していないが、次に、第2のポリシリコン層305上にフォトレジストを塗布し、これをフォトリソグラフィー技術によってパターニングしてエッチングのためのマスク306とする。その後、このようにして形成されたマスク306を利用して、例えばプラズマエッチングを行うことによって、図15(b)に示すように、シリコン基板301にトレンチ307を一気に形成し、各メモリ領域を分離する。

【0109】

次に、図16(a)に示すように、トレンチ307に対して本発明の方法に従ってプラズマ酸化処理を行い、トレンチ307の内表面にシリコン酸化膜308を形成する。このようにすることによって、トレンチ307の側壁におけるシリコン酸化膜308aの膜厚を底部のシリコン酸化膜308bの膜厚に比べて極端に薄く形成することができるため、本デバイスでは、個々のメモリ素子においてゲート長を長く取ることができる。

【0110】

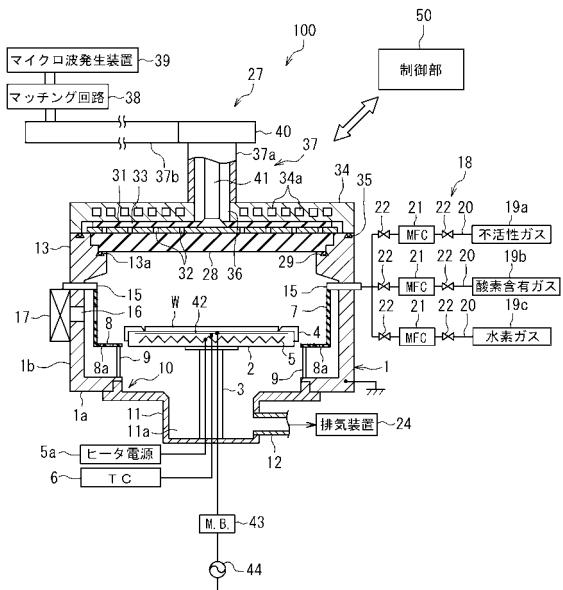
次に、図16(b)に示すように、マスク306を例えればアッシングによって除去し、適宜メタル配線(図示せず)を形成した後、例えばCVDまたはプラズマCVDによりSiO₂などの層間絶縁膜309を形成して、各メモリ領域を埋め込み、フラッシュメモリを完成する。上述したように、このフラッシュメモリでは、各メモリ素子の側壁に形成されるシリコン酸化膜の膜厚を非常に薄くすることが可能なため、素子を微細化しつつゲート長を長く取ることができる。これによって、メモリ容量が大きくかつ動作の信頼性が高いフラッシュメモリを得ることができる。

【符号の説明】

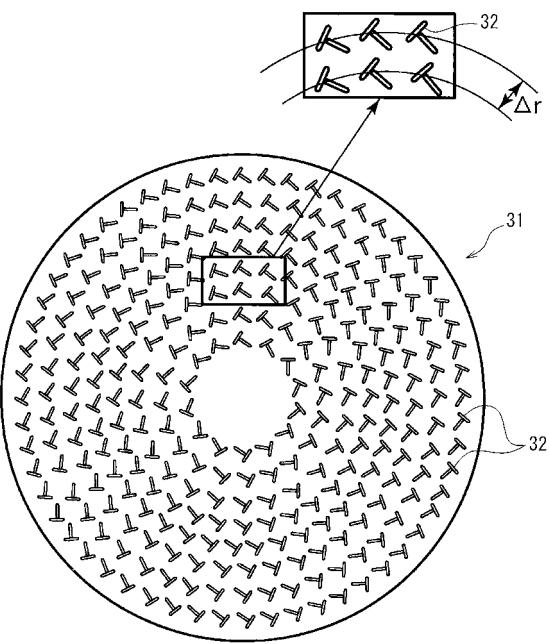
【0111】

1...チャンバー(処理室)、2...載置台、3...支持部材、5...ヒータ、12...排気管、15...ガス導入部、16...搬入出口、17...ゲートバルブ、18...ガス供給機構、19a...不活性ガス供給源、19b...酸素含有ガス供給源、19c...水素ガス供給源、24...排気装置、28...透過板、29...シール部材、31...平面アンテナ、32...マイクロ波放射孔、37...導波管、37a...同軸導波管、37b...矩形導波管、39...マイクロ波発生装置、50...制御部、51...プロセスコントローラ、52...ユーザーアンターフェース、53...記憶部、100...プラズマ処理装置、101...シリコン基板、102...シリコン酸化膜、103...シリコン窒化膜、105...トレンチ、120...パターン、121...シリコン酸化膜、200...ポリシリコン電極、W...半導体ウエハ(基板)

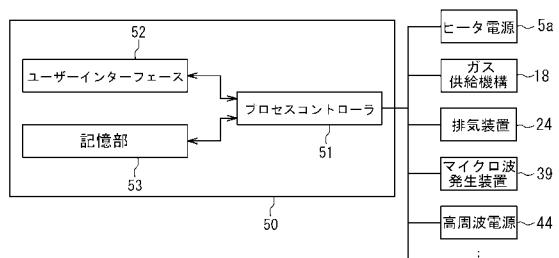
【図1】



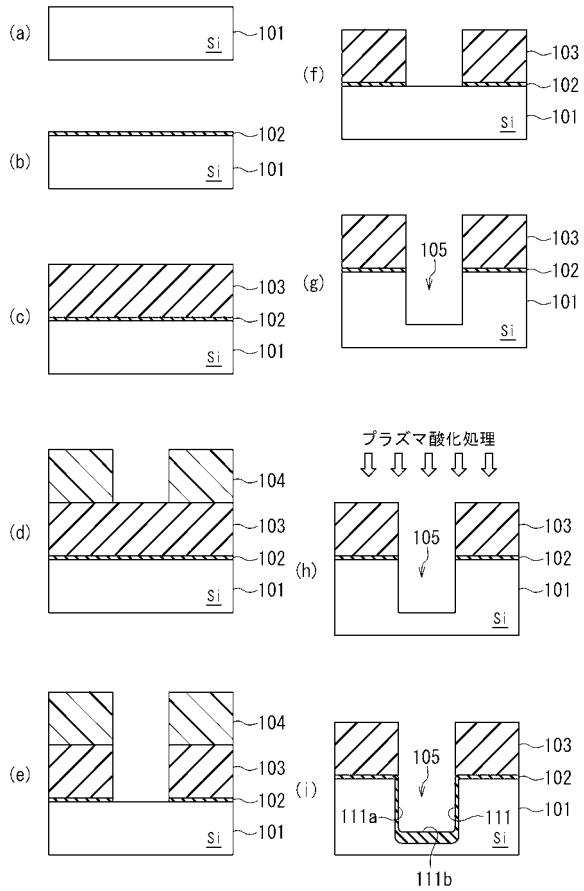
【図2】



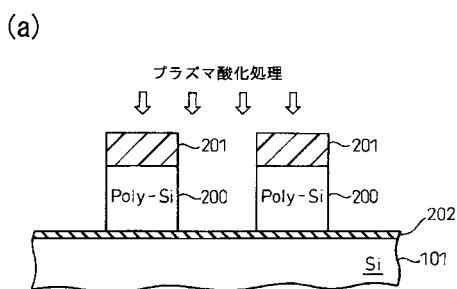
【図3】



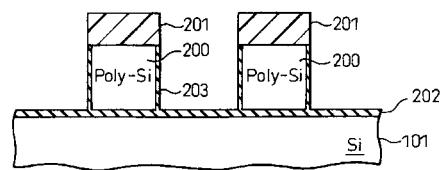
【図4】



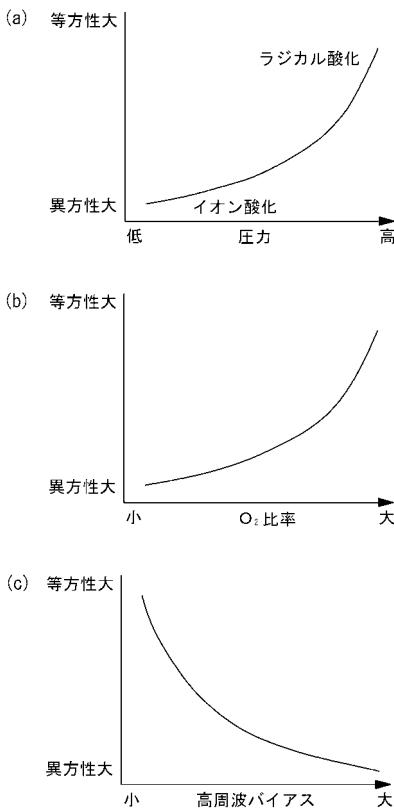
【図5】



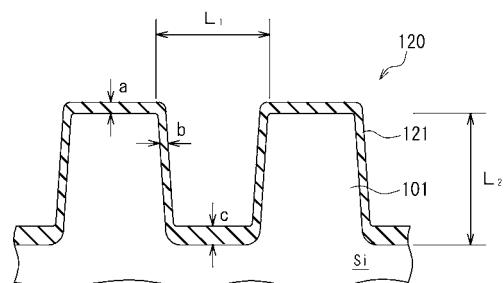
(b)



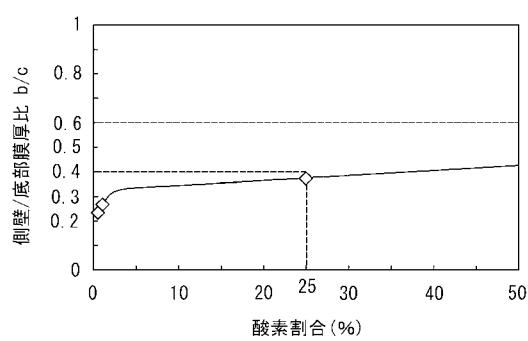
【図6】



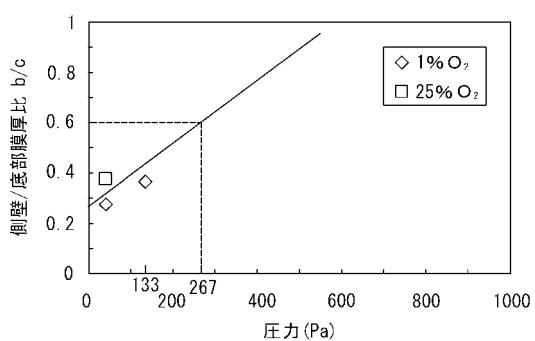
【図7】



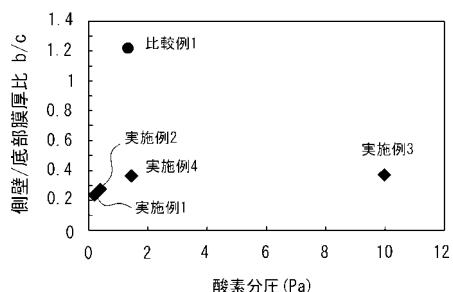
【図8】



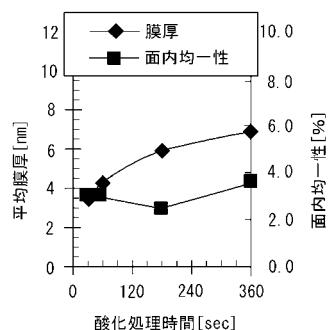
【図9】



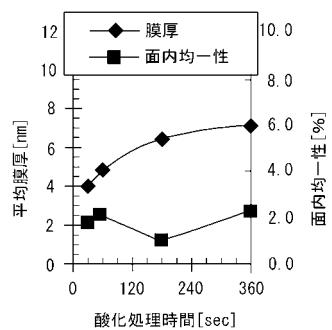
【図10】



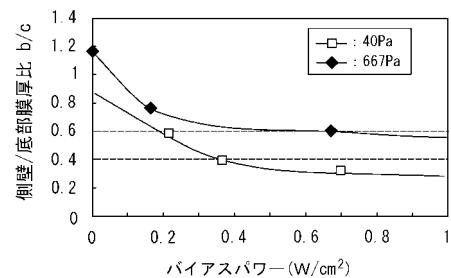
【図 1 1】



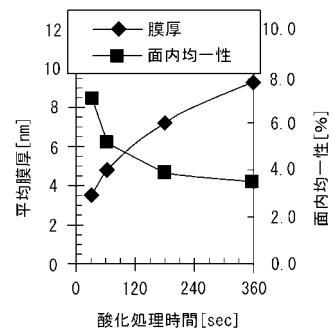
【図 1 2】



【図 1 3】

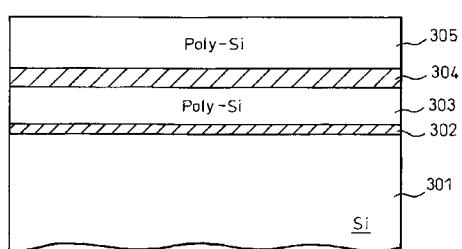


【図 1 4】

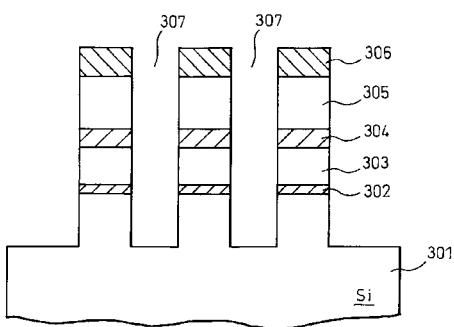


【図 1 5】

(a)

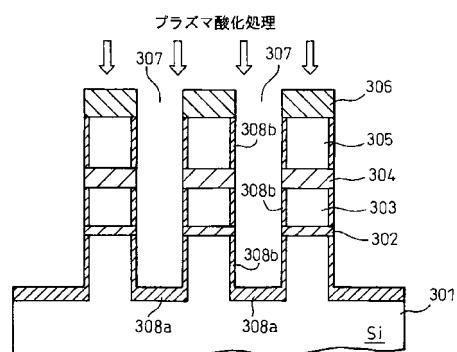


(b)

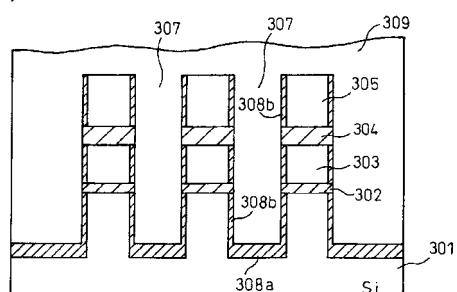


【図 1 6】

(a)



(b)



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
H 01 L 21/283 (2006.01)	H 01 L 27/10 4 3 4	5 F 1 0 1
H 01 L 21/8247 (2006.01)	H 01 L 29/78 3 7 1	
H 01 L 27/115 (2006.01)		
H 01 L 29/788 (2006.01)		
H 01 L 29/792 (2006.01)		

(72)発明者 北川 淳一

東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー 東京エレクトロン株式会社内

F ターム(参考) 4M104 AA01 BB01 CC05 DD65 DD86 DD89 EE09 GG09 GG14 GG16
5F032 AA34 AA36 AA44 AA45 AA67 AA70 CA17 DA02 DA23 DA25
DA53
5F048 AA04 AA07 AC01 BA01 BB01 BB05 BG13 DA25
5F058 BA06 BA20 BC02 BF08 BF73 BJ06
5F083 NA01 PR21 PR40
5F101 BD35 BH02